
	<h2 style="color: red;">FQP85N06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP85N06</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 85A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP85N06.pdf 2.FQP85N06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 75525 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP85N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 85A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	75525 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 85A (Tc) 160W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	85A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 42.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	112nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4120pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP85N06 ist neu im Original, Suche FQP85N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP85N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP85N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP7P20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220</p>	 <p>FQP8N60 FSC FQP8N60 FSC</p>	 <p>FQP8N25 FSC FQP8N25 FSC</p>	 <p>FQP8N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220</p>
 <p>FQP80N06 F F TO220</p>	 <p>FQP8874 FAIRCHILD FAIRCHI TO-220</p>	 <p>FQP8N50C VB FQP8N50C VB</p>	 <p>FQP7P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP6N40CF	↔ FQP6N50C	⇒ FQP6N50C	D FQP6N60C	↔ FQP6N60C
⊣ FQP6N80C	⊗ FQP6N80C	D FQP6N90C	⇒ FQP6N90C	↔ FQP70N03L
⊗ FQP70N06	⊣ FQP70N06C	⊗ FQP70N08	↔ FQP70N08	↔ FQP70N10
D FQP70N10	⊗ FQP7N10L	⊣ FQP7N10L	⊗ FQP7N20L	↔ FQP7N20L
⇒ FQP7N60C	↔ FQP7N65C	⊗ FQP7N65C	⊣ FQP7N80C	↔ FQP7N80C
↔ FQP85N06	⇒ FQP8N50C	D FQP8N60C	⊗ FQP8N60C	⊣ FQP8N65C
⊗ FQP8N80C	D FQP8N80C	⇒ FQP8N90C	↔ FQP8N90C	↔ FQP90N08
⊣ FQP90N08	⊗ FQP90N10V2	↔ FQP90N10V2	⇒ FQP90N08L	↔ FQP90N08L
⊗ FQP9N25C	⊣ FQP9N25C	⊗ FQP9N50C	D FQP9N50C	↔ FQP9N65C
↔ FQP9N90C	⊗ FQP9N90C	⊣ FQPF10N20	⊗ FQPF10N20	↔ FQPF10N20C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited